

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)**

Кафедра _____ Физики _____
(полное наименование кафедры)



Регистрационный №_23.09/171-Д

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наноэлектроника

(наименование дисциплины)
образовательная программа высшего образования

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

(код и наименование направления подготовки / специальности)

бакалавр

(квалификация)

Промышленная электроника

(направленность / профиль образовательной программы)

очная форма

(форма обучения)

Санкт-Петербург

Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению (специальности) подготовки «11.03.04 Электроника и наноэлектроника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 № 927, и в соответствии с рабочим учебным планом, утвержденным ректором университета.

1. Цели и задачи дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Нанoeлектроника» является:

формирование представлений о физических свойствах электронных систем различной размерности, о том, как влияет понижение размерности на физические явления, и какие новые эффекты при этом появляются.

Эта цель достигается путем решения следующих(ей) задач(и):

Задачи курса состоят в изложении принципиальных понятий физики твёрдого тела для систем с пониженной размерностью и развитие основ понимания физических процессов, протекающих в этих системах при внешних воздействиях, а также элементарные представления об использовании этих явлений при создании приборов нанoeлектроники.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Нанoeлектроника» Б1.В.13 является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 учебного плана подготовки бакалавриата по направлению «11.03.04 Электроника и нанoeлектроника». Изучение дисциплины «Нанoeлектроника» опирается на знания дисциплин(ы) «Волновая оптика и квантовая механика»; «Физика конденсированного состояния»; «Электроника».

3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Таблица 1

№ п/п	Код компетенции	Наименование компетенции
1	ОПК-1	Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности
2	ПК-2	Способен аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и нанoeлектроники различного функционального назначения

Индикаторы достижения компетенций

Таблица 2

ОПК-1.1	Знает фундаментальные законы природы и основные физические и математические законы
ОПК-1.2	Умеет применять физические законы и математические методы для решения задач теоретического и прикладного характера
ОПК-1.3	Владеет навыками использования знаний физики и математики при решении практических задач
ПК-2.1	Знает методики проведения исследований параметров и характеристик узлов, блоков
ПК-2.2	Умеет проводить исследования характеристик электронных приборов

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Таблица 3

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры	
			7	8
Общая трудоемкость	7 ЗЕТ	252	108	144
Контактная работа с обучающимися		102.6	50.25	52.35
в том числе:				
Лекции		40	20	20
Практические занятия (ПЗ)		32	16	16
Лабораторные работы (ЛР)		28	14	14
Защита контрольной работы			-	-
Защита курсовой работы			-	-
Защита курсового проекта			-	-
Промежуточная аттестация		2.6	0.25	2.35
Самостоятельная работа обучающихся (СРС)		115.75	57.75	58
в том числе:				
Курсовая работа			-	-
Курсовой проект			-	-
И / или другие виды самостоятельной работы: подготовка к лабораторным работам, практическим занятиям, контрольным работам, изучение теоретического материала		107.75	49.75	58
Подготовка к промежуточной аттестации		41.65	8	33.65
Вид промежуточной аттестации			Зачет	Экзамен

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины.

Таблица 4

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	№ семестра		
			очная	очно-заочная	заочная
1	Раздел 1. Сигналы в электронике	Электроны как носители сигналов. Квазичастицы как носители сигналов. Сравнительный анализ свойств частиц и квазичастиц. Квазичастицы для электроники. Носители в наноразмерных структурах. Баллистический транспорт носителей заряда. Туннелирование носителей заряда. Спин и спиновые эффекты. Динамические неоднородности как носители сигналов	7		
2	Раздел 2. Наноструктурные материалы	Зонная инженерия. Атомы, ионы и молекулы. Кристаллы и кристаллиты. Кластеры. Аллотропные модификации углерода. Квантовые наноструктуры. Ионный синтез квантовых наноструктур. Полупроводниковые гетероструктуры. Сверхрешетки. Фотонные кристаллы. Полимерные материалы. ДНК как компонент наноструктур. Мультиферроики	7		

3	Раздел 3. Физико-химия наноструктурных материалов	Процессы на поверхности и в приповерхностных слоях. Атомная структура поверхностного слоя. Свойства поверхности. Поверхностная ионизация. Адсорбция, десорбция и испарение с поверхности. Межфазные характеристики. Термодинамика поверхности. Термодинамические системы. Термодинамика неравновесных процессов.	7		
4	Раздел 4. Методы нанотехнологии	Молекулярно-лучевая эпитаксия. Газофазная эпитаксия из металлоорганических соединений. Формирование структур на основе коллоидных растворов. Золь-гель-технология. Методы молекулярного наслаивания и атомно-слоевой эпитаксии. Сверхтонкие пленки металлов и диэлектриков. Искусственное нанотормообразование. Формирование полупроводниковых и металлических нановолокон и спиралей. Наногфрированные структуры. Самоорганизация структур. Критерий Рэлея. Оптическая литография. Рентгеновская литография. Электронная литография. Ионная литография. Возможности пучковых методов нанолитографии в нанoeлектронике. Нанопечатная литография	7		
5	Раздел 5. Методы формирования наноструктур	Физические основы зондовой нанотехнологии. Контактное формирование нанорельефа. Бесконтактное формирование нанорельефа. Локальная глубинная модификация поверхности. Межэлектродный массоперенос. Массоперенос. Локальное анодное окисление. СТМ-литография. Совместное использование лазера и сканирующего туннельного микроскопа в нанолитографии. Нанобиотехнологии	8		
6	Раздел 6. Элементы и приборы нанoeлектроники	От битов к кубитам. Квантовые вычисления. Элементная база квантовых компьютеров. Молекулярный подход в нанoeлектронике. Молекулярные транзисторы и элементы логики. Молекулярная память. Полимерные материалы. Органические транзисторы. Органические светоизлучающие диоды. Эластичная электроника. Нанопроводники/ Зонные структуры фотонных кристаллов. Устройства на фотонных кристаллах. Фотонные транзисторы. Лазерные структуры с пониженной размерностью. Кванты плазмы твердых тел. Спазер — лазер на плазмонах. Однофотонный транзистор. Интегральные схемы на плазмонах. Кванты плазмы твердых тел. Спазер — лазер на плазмонах. Однофотонный транзистор. Интегральные схемы на плазмонах	8		

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.

«Нанoeлектроника» является дисциплиной, завершающей теоретическое обучение по программе 11.03.04 Электроника и нанoeлектроника

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий.

Очная форма обучения

Таблица 5

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лек-ции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Семи-нары	СРС	Всего часов
1	Раздел 1. Сигналы в электронике	4	4	4		15	27
2	Раздел 2. Наноструктурные материалы	8	4	4		15	31
3	Раздел 3. Физико-химия наноструктурных материалов	4	4	4		9.75	21.75
4	Раздел 4. Методы нанотехнологии	4	4	2		10	20
5	Раздел 5. Методы формирования наноструктур	4	2	8		20	34
6	Раздел 6. Элементы и приборы нанoeлектроники	16	14	6		38	74
Итого:		40	32	28	-	107.75	207.75

6. Лекции

Очная форма обучения

Таблица 6

№ п/п	Номер раздела	Тема лекции	Всего часов
1	1	От микро- к нанoeлектронике. Микроeлектроника сегодня	2
2	1	Электронны как носители сигналов. Квазичастицы как носители сигналов	2
3	2	Зонная инженерия. Атомы, ионы и молекулы. Кристаллы и кристаллиты. Кластеры. Аллотропные модификации углерода. Квантовые наноструктуры	2
4	2	Ионный синтез квантовых наноструктур. Полупроводниковые гетероструктуры. Сверхрешетки	2
5	2	Фотонные кристаллы. Полимерные материалы. ДНК как компонент наноструктур	2
6	2	Мультиферроики	2
7	3	Процессы на поверхности и в приповерхностных слоях	2
8	3	Термодинамика поверхности. Термодинамические системы. Термодинамика неравновесных процессов	2
9	4	Гетерогенные процессы формирования наноструктур	2
10	4	Методы получения упорядоченных наноструктур	2
11	5	Литографические методы формирования наноструктур	2
12	5	Методы зондовой нанотехнологии	2
13	6	Нанотранзисторные структуры	2
14	6	Одноeлектронная нанoeлектроника	2
15	6	Спинтроника	2
16	6	Квантовые компьютеры	2
17	6	Молеетроника	2
18	6	Политроника	2
19	6	Нанофотоника. Наноплазмоника	2
20	6	Мемристормая электроника	2

Итого:	40
--------	----

7. Лабораторный практикум

Очная форма обучения

Таблица 7

№ п/п	Номер раздела	Наименование лабораторной работы	Всего часов
1	1	Особенности энергетического спектра частиц в системах пониженной размерности	2
2	1	Исследование статистических свойств носителей заряда в полупроводниках	2
3	2	Низкоразмерные структуры	2
4	2	Проводимость низкоразмерных структур	2
5	3	Поверхностные и кинетические явления в полупроводниках	2
6	3	Контактные явления в полупроводниках	2
7	4	Самоорганизация структур	2
8	5	Оптические методы исследования наноструктур	2
9	5	Манипулирование нанообъектами и управление наноперемещениями	2
10	5	Обработка структур	2
11	5	Исследование наноструктур методами сканирующей зондовой микроскопии	2
12	6	Туннелирование носителей заряда через потенциальные барьеры. Одноэлектронное туннелирование. Резонансное туннелирование	2
13	6	Спин-зависимый транспорт носителей заряда. Гигантское магнитосопротивление. Спин-контролируемое туннелирование	2
14	6	Устройства с применением нанотехнологий	2
Итого:			28

8. Практические занятия (семинары)

Очная форма обучения

Таблица 8

№ п/п	Номер раздела	Тема занятия	Всего часов
1	1	Элементы квантовой механики: операторы, уравнение Шредингера, движение микрочастиц в свободном пространстве	2
2	1	Элементы квантовой механики: электрон в потенциальной яме, прохождения микрочастицы через потенциальный барьер	2
3	2	Статистика носителей заряда в полупроводниках: функции распределения микрочастиц по энергиям, уровень Ферми в полупроводниках	2
4	2	Явления в низкоразмерных структурах: квантовое ограничение, баллистический транспорт и туннелирование	2
5	3	Кинетика десорбции. Поверхностное давление. Термодинамика поверхности	2
6	3	Исследование диффузионных процессов при контакте двух полупроводников	2
7	4	Структуры с квантовым ограничением. Квантовые ямы. Контактное и безконтактное формирование нанорельефа	2
8	4	Самоорганизация	2

9	5	Проводимость низкоразмерных структур	2
10	6	Кинетические явления в полупроводниках: подвижность электронов и дырок	2
11	6	Контактные явления в р n-переходе	2
12	6	Поверхностные явления в р n-переходе	2
13	6	Резонансное туннелирование	2
14	6	Гигантское магнитосопротивление	2
15	6	Спин-контролируемое туннелирование	2
16	6	Выходные электрические характеристики нанотранзисторов	2
Итого:			32

9. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Рабочим учебным планом не предусмотрено

10. Самостоятельная работа

Очная форма обучения

Таблица 9

№ п/п	Номер раздела	Содержание самостоятельной работы	Форма контроля	Всего часов
1	1	Подготовка к лаб. работам и практическим занятиям. Решение задач. Подготовка к зачету.	Собеседование, проверка отчетов и задач	15
2	2	Подготовка к лаб. работам и практическим занятиям. Решение задач. Подготовка к зачету.	Собеседование, проверка отчетов и задач	15
3	3	Подготовка к лаб. работам и практическим занятиям. Решение задач. Подготовка к зачету.	Собеседование, проверка отчетов и задач	9.75
4	4	Подготовка к лаб. работам и практическим занятиям. Решение задач. Подготовка к экзамену.	Собеседование, проверка отчетов и задач	10
5	5	Подготовка к лаб. работам и практическим занятиям. Решение задач. Подготовка к экзамену.	Собеседование, проверка отчетов и задач	20
6	6	Подготовка к лаб. работам и практическим занятиям. Решение задач. Подготовка к экзамену.	Собеседование, проверка отчетов и задач	38
Итого:				107.75

11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Для самостоятельной работы по дисциплине рекомендовано следующее учебно-методическое обеспечение:

- Положение о самостоятельной работе студентов в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича;
- рекомендованная основная и дополнительная литература;
- конспект занятий по дисциплине;

- слайды-презентации и другой методический материал, используемый на занятиях;
- методические рекомендации по подготовке письменных работ, требования к их содержанию и оформлению (реферат, эссе, контрольная работа) ;
- фонды оценочных средств;
- методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов;

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Фонд оценочных средств разрабатывается в соответствии с локальным актом университета "Положение о фонде оценочных средств" и является приложением (Приложение А) к рабочей программе дисциплины.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и критерии оценки сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.

13. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

13.1. Основная литература:

1. Игнатов, А. Н.

Оптоэлектроника и нанофотоника : [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Игнатов. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 596 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/119822>. - ISBN 978-5-8114-4437-3 : Б. ц. Книга из коллекции Лань - Физика . - [Б. м. : б. и.]. - <https://e.lanbook.com/book/95150>

2. Шука, А. А.

Нанoeлектроника : учебник для вузов / А. А. Шука ; ред. А. С. Сигов. - М. : Юрайт, 2020. - 296 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-9916-8280-0 : 1075.30 р. - Текст : непосредственный.

13.2. Дополнительная литература:

1. Троян, П. Е.

Твердотельная электроника : [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Е.

Троян. - М. : ТУСУР, 2008. - 330 с. - URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4966. - Б. ц. Книга из коллекции ТУСУР - Инженерно-технические науки

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- www.sut.ru
- lib.spbgut.ru/jirbis2_spbgut

15. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

15.1. Программное обеспечение дисциплины:

- Open Office
- Google Chrome

15.2. Информационно-справочные системы:

- ЭБС iBooks (<https://ibooks.ru>)
- ЭБС Лань (<https://e.lanbook.com/>)
- ЭБС СПбГУТ (<http://lib.spbgut.ru>)

16. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

15.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины

Важным условием успешного освоения дисциплины «Нанoeлектроника» является создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Все задания, включая вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующего аудиторного занятия (лекции, практического занятия), что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает определенной спецификой.

15.2. Подготовка к лекциям

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета, как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

15.3. Подготовка к практическим занятиям

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке пройденного материала (материала лекций, практических занятий), а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

Необходимо понимать, что невозможно во время аудиторных занятий изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов, и при изучении дисциплины недостаточно конспектов занятий. Поэтому самостоятельная работа с учебниками,

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

15.4. Рекомендации по работе с литературой

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического

характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадах. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информация может быть использована при написании текста реферата или другого задания.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).

15.5. Подготовка к промежуточной аттестации

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

17. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Таблица 10

№ п/п	Наименование специализированных аудиторий и лабораторий	Наименование оборудования
1	Лекционная аудитория	Аудио-видео комплекс
2	Аудитории для проведения групповых и практических занятий	Аудио-видео комплекс

3	Компьютерный класс	Персональные компьютеры
4	Аудитория для курсового и дипломного проектирования	Персональные компьютеры
5	Аудитория для самостоятельной работы	Компьютерная техника
6	Читальный зал	Персональные компьютеры

Лист изменений № 1 от 9 января 2020 г

Рабочая программа дисциплины
«Наноэлектроника»

Код и наименование направления подготовки/специальности:

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Направленность/профиль образовательной программы:

Промышленная электроника

Из п. 14.2 Информационно-справочные системы исключить с 08.01.2020 г. строку: ЭБС IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>)

Основание: прекращение контракта № 4784/19 от 25.01.2019 г. на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks.

Внесенные изменения утверждаю:

Начальник УМУ _____ Л.А. Васильева